

УДК 535.375.5 + 621.373 : 535] : 546.35

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКР
В ПАРАХ РУБИДИЯ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ
ВБЛИЗИ ПЕРЕХОДОВ $5^2S_{1/2}$ — $5^2P_{1/2}, 3/2$

Н. В. Знаменский, В. А. Михайлов и В. И. Одинцов

Экспериментально исследовано положение и форма линии ВКР при возбуждении паров рубидия излучением лазеров на красителях с перестраиваемой частотой и узкой ($\sim 0.2 \text{ см}^{-1}$) линией генерации. С целью выявления действия оптического эффекта Штарка на линию ВКР интенсивность излучения, заселяющего исходный для ВКР уровень $5^2P_{1/2}$ или $5^2P_{3/2}$, изменялась в широких пределах до $\sim 20 \text{ МВт/см}^2$, а его частота перестраивалась в окрестности резонансного перехода, включая точную настройку в резонанс. Установлено, что эффект Штарка в линии ВКР не проявляется.

ВКР вблизи резонансных переходов Rb наблюдалось в [1] и исследовалось в условиях перестройки частоты возбуждающего излучения в [2, 3]. Однако в этих исследованиях остался не выясненным вопрос о проявлении в линии ВКР смещения атомных уровней, происходящего вследствие оптического эффекта Штарка. В [5] отмечается регистрация штарковского смещения линии ВКР в парах калия, однако результаты, приводящиеся в [4, 5], неоднозначны.

В настоящей работе для выявления действия оптического эффекта Штарка при резонансном ВКР было проведено исследование положения, формы и ширины линии ВКР при возбуждении паров Rb излучением одного или двух лазеров на красителях с перестраиваемой частотой и узкой ($\sim 0.2 \text{ см}^{-1}$) линией генерации (см. также [6]). Длительность возбуждающего импульса составляла 25 нс. Диаметр светового пучка в кювете с парами рубидия длиной 18 см был $\sim 1 \text{ мм}$.

При работе с двумя лазерами на красителях их световые пучки совмещались в пространстве с помощью системы зеркал, а синхронность их импульсов генерации обеспечивалась возбуждением обоих лазеров одним и тем же импульсом рубинового лазера. ВКР исследовалось при температуре паров от 200 до 280°C . Излучение, выходящее из кюветы, направлялось на щель дифракционного спектрографа с линейной дисперсией $5 \text{ см}^{-1}/\text{мм}$. Спектральная ширина щели составляла 0.08 см^{-1} . Частота линии ВКР определялась с точностью не ниже 0.2 см^{-1} .

При использовании двух лазеров на красителях частота одного из них (лазера A) ω_A настраивалась на частоту перехода $5^2S_{1/2}$ — $5^2P_{1/2}$ или $5^2S_{1/2}$ — $5^2P_{3/2}$, что обеспечивало заселение соответствующего верхнего уровня (рис. 1, a, б). Второй лазер осуществлял возбуждение ВКР с этого уровня. Его частота ω_B была близка к частоте другого резонансного перехода. Чтобы избежать самофокусировки излучения лазера B, частота ω_B перестраивалась с длинноволновой стороны от этого перехода. При этом канал просветления среды, создаваемый излучением лазера A, препятствовал проявлению самодефокусировки излучения лазера B, образуя для него оптический волновод [3]. Работа проводилась при достаточно низких температурах паров (220°C), при которых лазер A сам по себе не мог возбуждать ВКР. Интенсивность лазера A варьировалась в широких пределах до $\sim 20 \text{ МВт/см}^2$.

Штарковское смещение линии ВКР должно быть наибольшим в случае, когда импульс ВКР развивается вблизи максимума импульса заселяющего лазера. Было установлено, что последнее происходит, когда интенсивность лазера B близка к порогу возбуждения ВКР. Поэтому линия ВКР фотографировалась при минимальной интенсивности возбуждающего лазера B .

При настройке частоты ω_A на частоту перехода $5^2S_{1/2} - 5^2P_{3/2}$ (рис. 1, а) ВКР возбуждалось в виде узкой линии шириной $\Delta\omega_S \leq 0.5 \text{ см}^{-1}$. Ее частота ω_S обнаруживала лишь незначительный сдвиг ($\leq 0.5 \text{ см}^{-1}$) в коротковолновую сторону от «несмещенной» частоты ω_S^0 , определяемой положением невозмущенных атомных уровней. С уменьшением интенсивности заселяющего лазера A I_A величина смещения линии ВКР уменьшалась. При перестройке частоты ω_A в пределах $\pm 5 \text{ см}^{-1}$ линия ВКР по-прежнему

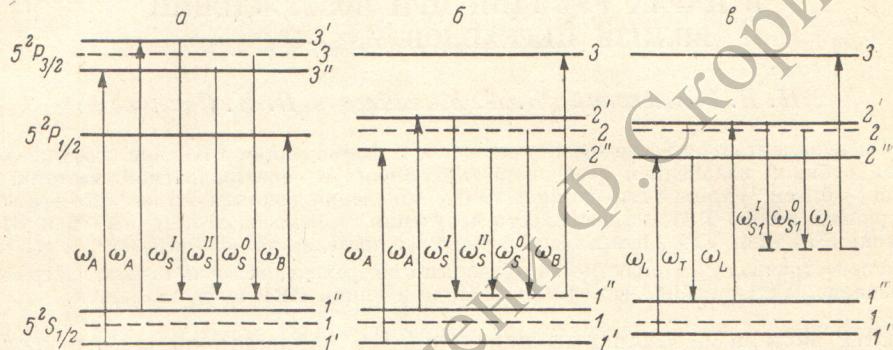


Рис. 1. Схема возбуждения ВКР вблизи резонансных переходов рубидия с учетом штарковского возмущения энергетических уровней.

$1'', 1''', 2'', 2', 3'', 3'$ — уровни квазиэнергии; $1, 2, 3$ — невозмущенные энергетические уровни; ω_T — частота вынужденного трехфотонного рассеяния света.

была смещена в коротковолновую сторону относительно «несмещенной» частоты ω_S^0 на величину $\sim 0.5 \text{ см}^{-1}$. Как и в случае точного резонанса, с уменьшением интенсивности I_A величина смещения линии ВКР уменьшалась.

При настройке частоты ω_A на частоту перехода $5^2S_{1/2} - 5^2P_{1/2}$ (рис. 1, б) при длинноволновых расстройках возбуждающего лазера B Δ_B менее 30 см^{-1} наблюдалась узкая линия ВКР с шириной $\Delta\omega_S \leq 0.5 \text{ см}^{-1}$, не испытывавшая существенного смещения относительно частоты ω_S^0 . При расстройках Δ_B более 30 см^{-1} с длинноволновой стороны у линии ВКР появлялось слабое крыло. С увеличением интенсивностей лазеров A и B протяженность крыла возрастала и могла достигать $\sim 4 \text{ см}^{-1}$. При смещении частоты ω_A с резонанса в ту или другую сторону положение и ширина линии ВКР не изменялись.

Сопоставим результаты наших экспериментальных исследований с имеющейся теорией проявления эффекта Штарка в спектре ВКР [7]. Согласно [7], при рассмотрении ВКР как двухфотонного процесса, начинающегося с возбужденного состояния $5^2P_{3/2}$ или $5^2P_{1/2}$, при нулевой расстройке частоты лазера A $\Delta_A = 0$ следует ожидать штарковского расщепления линии ВКР на две компоненты с частотами ω_S^I и ω_S^{II} , определяемыми положением уровней квазиэнергии $2''$ и $2'''$ или $3''$ и $3'''$ (рис. 1, а, б). Расчет показывает, что при интенсивности заселяющего лазера $I_A = 20 \text{ МВт}/\text{см}^2$ разность $\omega_S^I - \omega_S^{II}$ должна составлять $\sim 9.5 \text{ см}^{-1}$, если исходным для ВКР является уровень $5^2P_{1/2}$, и $\sim 13 \text{ см}^{-1}$, если исходный уровень $5^2P_{3/2}$. Эксперименты же показали, что штарковское расщепление уровней под действием мощного поля заселяющего лазера A в спектре ВКР не проявляется. Наблюдавшееся небольшое коротковолновое смещение при перестройке частоты ω_A вблизи перехода $5^2S_{1/2} - 5^2P_{3/2}$ не может быть связано со штарковским, поскольку при коротковолновых

расстройках частоты лазера A штарковское смещение линии ВКР должно происходить в длинноволновую сторону. В экспериментах же наблюдалось только коротковолновое смещение линии ВКР, не говоря уже о том, что величина этого смещения была значительно меньше, чем это следует из теории. Уширение линии ВКР, наблюдавшееся при перестройке частоты ω_A вблизи перехода $5^2S_{1/2} - 5^2P_{1/2}$, также нельзя считать штарковским по аналогичным соображениям.

Таким образом, установлено существенное расхождение между теорией и экспериментальными результатами. Согласно последним, штарковское возмущение энергетических уровней в спектре ВКР не проявляется. В качестве иллюстрации на рис. 2 приведены две фотографии линии ВКР при различных интенсивностях и расстройках частоты заселяющего лазера A . Хорошо видно, что при изменении интенсивности заселяющего лазера A I_A от 20 до 1 МВт/см² положение линии ВКР не изменяется.

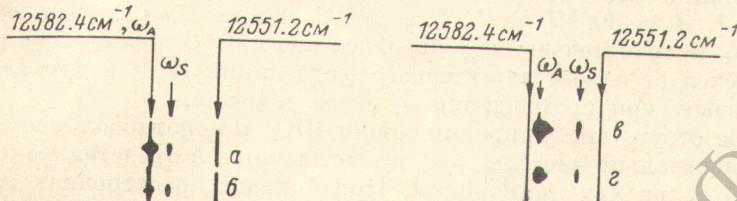


Рис. 2. Положение линии ВКР при различных интенсивностях I_A и расстройках Δ_A заселяющего лазера A .

$a - I_A = 20 \text{ МВт/см}^2, \Delta_A = 0$; $b - I_A = 1 \text{ МВт/см}^2, \Delta_A = 0$; $c - I_A = 20 \text{ МВт/см}^2, \Delta_A = -4 \text{ см}^{-1}$; $d - I_A = 1 \text{ МВт/см}^2, \Delta_A = -4 \text{ см}^{-1}$. Расстройка возбуждающего лазера B $\Delta_B = -8.8 \text{ см}^{-1}$ (a, b) и -21.8 см^{-1} (c, d).

Были также проведены экспериментальные исследования проявления эффекта Штарка в спектре ВКР при его возбуждении излучением лишь одного лазера на красителях. Температура паров рубидия в этих экспериментах составляла 260°С. Заселение исходных для ВКР уровней $5^2P_{1/2}$ или $5^2P_{3/2}$ в случае достаточно больших расстроек Δ_L частоты возбуждающего излучения ω_L от частоты атомных переходов $5^2S_{1/2} - 5^2P_{1/2}$ или $5^2S_{1/2} - 5^2P_{3/2}$ осуществлялось с помощью процесса вынужденного трехфотонного рассеяния света [1, 6]. Исключение составляла область расстроек $|\Delta_L| \leq 1 \text{ см}^{-1}$, в которой заселение исходных уровней $5^2P_{1/2}$ или $5^2P_{3/2}$ за счет прямого однофотонного поглощения преобладало над трехфотонным заселением.

При перестройке частоты возбуждающего излучения вблизи переходов $5^2S_{1/2} - 5^2P_{1/2}, 5^2P_{3/2}$ возникают эффекты самовоздействия, которые могут оказывать существенное влияние на интенсивность возбуждающего пучка. Было установлено (см. подробнее [6]), что существует примыкающая к резонансу область длинноволновых расстроек Δ_L , в которой достаточно интенсивное излучение накачки не претерпевает самодефокусировки. С уменьшением интенсивности возбуждающего лазера I_L протяженность этой области уменьшается. Например, для перехода $5^2S_{1/2} - 5^2P_{1/2}$ при $I_L \approx 30 \text{ МВт/см}^2$ самодефокусировка отсутствует при длинноволновых расстройках менее $\sim 15 \text{ см}^{-1}$ и наблюдается при больших значениях Δ_L . Переход в область коротковолновых расстроек сопровождается скачкообразным переходом от случая отсутствия самовоздействия к случаю самодефокусировки. Очевидно, что надежная интерпретация экспериментальных результатов и сопоставление их с теоретическими оценками возможны лишь в том случае, когда частота накачки расположена с длинноволновой стороны от резонанса в области, в которой эффекты самовоздействия отсутствуют.

При перестройке частоты ω_L в окрестностях перехода $5^2S_{1/2} - 5^2P_{1/2}$ стоксова компонента ВКР ω_{S1} обнаруживала значительное уширение, направленное независимо от знака расстройки Δ_L в длинноволновую сто-

рону от «несмещенной» частоты ω_{S1}^0 . Однако величина этого смещения и форма линии существенно различались для разных знаков Δ_L .

При длинноволновых расстройках ($\Delta_L < 0$) контур линии ВКР имел резкий край с коротковолновой стороны и более или менее протяженное крыло с другой. Протяженность длинноволнового крыла и ширина линии на половине высоты $\Delta\omega_{S1}$ возрастили при увеличении I_L и температуры паров и уменьшались при удалении ω_L от резонанса. При $I_L \approx \approx 30 \text{ МВт/см}^2$, $t^0 \approx 260^\circ \text{C}$ $\Delta\omega_{S1} \approx 1 \text{ см}^{-1}$ в случае расстроек от 0 до -2 см^{-1} ; при увеличении расстройки до $\Delta_L = -5 \text{ см}^{-1}$ $\Delta\omega_{S1}$ уменьшалась до $\sim 0.5 \text{ см}^{-1}$. При всех значениях I_L и $\Delta_L < 0$ максимум линии ВКР всегда был смещен в длинноволновую сторону относительно «несмещенной» частоты ω_{S1}^0 на величину $\leq 0.5 \text{ см}^{-1}$.

При коротковолновых расстройках ($\Delta_L > 0$) линия ВКР имела резкий край с коротковолновой стороны, который располагался на частоте ω_{S1}^0 . Ширина линии ВКР была значительно больше, чем при $\Delta_L < 0$. Так, при $\Delta_L \approx 4 \text{ см}^{-1}$, $I_L \approx 30 \text{ МВт/см}^2$, $t^0 \approx 260^\circ \text{C}$ $\Delta\omega_{S1} \approx 3 \text{ см}^{-1}$. Она мало зависела от Δ_L и значительно медленнее, чем при $\Delta_L < 0$, возрастила с ростом I_L и t^0 . Переход от одного характерного вида линии ВКР к другому происходил скачком при прохождении ω_L через резонанс.

Полное отсутствие уширения линии ВКР в коротковолновом направлении относительно частоты ω_{S1}^0 не согласуется с представлением о расщеплении ее на две компоненты. При больших расстройках заселение уровня квазиэнергии $2'$ (рис. 1, б) происходит путем трехфотонного рассеяния [6]. В этом случае можно было ожидать возникновения линии ВКР на частоте ω_{S1}^I . Однако при $\Delta_L < 0$ частота ω_{S1}^I должна быть смещена в коротковолновую сторону относительно ω_{S1}^0 , что не согласуется с экспериментально наблюдаемым уширением линии ВКР только в длинноволновом направлении. При $\Delta_L > 0$ ω_{S1}^I смещена, как и наблюдаемая линия, в длинноволновую сторону от ω_{S1}^0 . Однако какие-либо количественные оценки в этом случае затруднены вследствие самофокусировки возбуждающего излучения.

При настройке частоты ω_L на частоту перехода $5^2S_{1/2} - 5^2P_{3/2}$ ¹ линия ВКР, как и в экспериментах с двумя лазерами, имела малую ширину $\leq 0.5 \text{ см}^{-1}$. Ее частота ω_{AS1} обнаруживала лишь незначительный сдвиг ($\leq 0.5 \text{ см}^{-1}$) в коротковолновую сторону относительно «несмещенной» частоты ω_{AS1}^0 , определяемой положением невозмущенных атомных уровней. Такая картина наблюдалась при различных значениях I_L вплоть до 30 МВт/см^2 . Положение линии ВКР относительно частоты ω_{AS1}^0 и ее ширина не менялись также при изменении Δ_L в обе стороны от резонанса. В то же время, согласно [7], при $\Delta_L = 0$ следовало ожидать расщепления и линии ВКР на две компоненты с частотами ω_{AS1}^I и ω_{AS1}^{II} . Если интенсивность накачки значительно превышала порог возбуждения ВКР, то импульс ВКР должен возникать в начале возбуждающего импульса. Поэтому, беря в качестве нижней границы штарковское расщепление при интенсивности $I_L = 2 \text{ МВт/см}^2$, соответствующей экспериментальному порогу возбуждения ВКР при $t = 260^\circ \text{C}$, получим $\omega_{AS1}^I - \omega_{AS1}^{II} \geq 4 \text{ см}^{-1}$, что опять-таки противоречит результатам эксперимента.

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования проявления оптического эффекта Штарка в спектре ВКР показали, что линия ВКР не испытывает штарковского смещения или расщепления энергетических уровней. Этот вывод не согласуется с результатами теоретического расчета [7]. Возможной причиной несоответствия эксперимента и теории [7] является то, что в экспериментах излучение накачки нельзя считать строго монохроматическим. Между тем при определенных условиях не-монохроматичность накачки может оказывать существенное влияние на штарковское возмущение энергетических уровней [8].

¹ Чтобы полностью исключить возникновение самофокусировки, частота ω_L смещалась в длинноволновую сторону от резонанса на малую величину $\sim 0.1 - 0.2 \text{ см}^{-1}$.

Литература

- [1] Н. Н. Бадалян В. А. Ирадян, М. Е. Мовсесян. Письма ЖЭТФ, 8, 518, 1968.
- [2] Ф. А. Королев, С. А. Бахрамов, В. И. Одинцов. Письма ЖЭТФ, 12, 436, 1970.
- [3] В. А. Михайлов, В. И. Одинцов, Л. Ф. Рогачева. Письма ЖЭТФ, 25, 151, 1977.
- [4] В. М. Арутюнян, Н. Н. Бадалян, В. А. Ирадян, М. Е. Мовсесян. ЖЭТФ, 60, 62, 1971.
- [5] В. М. Арутюнян, Т. А. Папазян, Ю. С. Чилингарян, А. В. Карменян, С. М. Саркисян. ЖЭТФ, 66, 509, 1974.
- [6] В. А. Михайлов, В. И. Одинцов. Деп. ВИНИТИ, № 4209-77, 1977.
- [7] М. А. Kovner, C. K. Potapov, Zh. prikl. spektr., 13, 243, 1970.
- [8] A. M. Bonch-Bruевич, S. G. Przhibelskiy, V. A. Hodovoy, N. A. Chigirin. ЖЭТФ, 70, 445, 1976.

Поступило в Редакцию 15 февраля 1979 г.